

本期封面



2001年1期

栏目:

DOI:

论文题目: A1N/聚乙烯复合材料的介电性能

作者姓名: 汪雨荻 周和平 乔梁 金海波 傅仁利

工作单位: 清华大学材料科学与工程系新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室, 北京100084

通信作者: 周和平

通信作者Email: zhp_dms@mail.tsinghua.edu.cn

文章摘要: 利用模压法制备A1N/聚乙烯复合基板. 研究了A1N的添加量和形态对复合基板的介电性能的影响, 结果表明, 随A1N含量的增加, 介电常数及介质损耗均增加. 在同一添加量下, 纤维A1N的介电常数最大, 晶须A1N次之, 粉体A1N最小; 而粉体A1N的介质损耗最大, 纤维A1N次之, 晶须A1N最小. 复合材料介电常数的计算模型可描述为: $\epsilon_k = \psi_1 \epsilon_{k1} + \psi_2 \epsilon_{k2} + \psi_3 \epsilon_{k3}$.

关键词: A1N, 介电常数, 复合材料, 聚乙烯

分类号: TG148

关闭